

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРОТОКОЛ № 2/21**

рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе  
на предоставление субсидий из федерального бюджета

г. Москва

11 сентября 2014 г.

**Предмет конкурса:** проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426 по приоритетному направлению «Индустрия наносистем» (мероприятие 1.3, 21 очередь) по проектам:

лот 1. Шифр: 2014-14-579-0096 «Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и/или силовых приборов»;

лот 2. Шифр: 2014-14-579-0095 «Разработка технологии получения нового поколения ком-бинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол»;

лот 3. Шифр: 2014-14-579-0094 «Разработка технологии производства и композиции конструкционного материала с повышенной термической и радиационной стойкостью для энергетических установок нового поколения»;

лот 4. Шифр: 2014-14-579-0149 «Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых, диэлектрических и металлических материалов для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности».

**На заседании конкурсной комиссии присутствовали:**

Антропов Алексей Петрович

Боков Михаил Владимирович

Грузинова Елена Николаевна

Егоров Сергей Витальевич

Скуратов Алексей Константинович

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета началась 11 сентября 2014 г. по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11.

По результатам рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, конкурсная комиссия решила:

1. Допустить к участию в конкурсном отборе и признать его участниками участников конкурса согласно приложению к настоящему протоколу.

Подписи:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Антропов А.П.

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_ Грузинова Е.Н.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Боков М.В.

\_\_\_\_\_ Егоров С.В.

\_\_\_\_\_ Скуратов А.К.

15.09.2014

Приложение № 1 к протоколу № 2/21 рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

**О допуске к участию в конкурсном отборе**

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Уникальный номер заявки	Заявленная тема работ	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Запрашиваемый объем финансирования (млн. руб.)			
					Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.
<b>Лот 1. № 2014-14-579-0096 «Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и/или силовых приборов»</b>								
1	2014-14-579-0096-001	9192	Разработка технологии получения эпитаксиальных гетероструктур арсенидов галлия и алюминия для нового поколения силовых приборов	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики микроструктур Российской академии наук	40	25	7,5	7,5
2	2014-14-579-0096-002	0958	Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур АЗВ5 для силовых приборов нового поколения	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук	40	25	7,5	7,5
3	2014-14-579-0096-003	3710	Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и силовых приборов	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"	40	25	7,5	7,5
4	2014-14-579-0096-004	2587	Разработка технологии хлоридно-гидридной эпитаксии GaN структур на низкодефектных подложках карбида кремния 4H политипа для высоковольтных мощных PiN -диодов.	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"	24	15	4,5	4,5
5	2014-14-579-0096-005	7418	Разработка СВЧ плазменной технологии получения эпитаксиальных карбид кремниевых гетероструктур на кремниевой подложке для нового поколения СВЧ и силовых приборов	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук	40	25	7,5	7,5

<b>Лот 2. № 2014-14-579-0095 «Разработка технологии получения нового поколения ком-бинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол»</b>								
6	2014-14-579-0095-006	2533	Разработка технологии получения нового поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана"	35	15	10	10
7	2014-14-579-0095-007	0886	Разработка технологии получения нового поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол.	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет"	35	15	10	10
<b>Лот 3. № 2014-14-579-0094 «Разработка технологии производства и композиции конструкционного материала с повышенной термической и радиационной стойкостью для энергетических установок нового поколения»</b>								
8	2014-14-579-0094-008	5756	Разработка композиции и технологии производства нового термически стабильного и радиационно-стойкого титанового сплава для энергетических установок нового поколения	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей"	40	25	7,5	7,5
9	2014-14-579-0094-009	2922	Разработка системы легирования и технологии изготовления теплостойкой, радиационнстойкой и малоактивирующейся стали с оптимизированной наноструктурой для ядерных реакторов нового поколения	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"	40	25	7,5	7,5
10	2014-14-579-0094-010	3842	Разработка композиции и технологии изготовления высокопрочной, радиационнстойкой и теплостойкой стали с оптимизированной наноструктурой для перспективных ядерных реакторов	Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"	40	25	7,5	7,5
<b>Лот 4. № 2014-14-579-0149 «Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых, диэлектрических и металлических материалов для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности»</b>								
11	2014-14-579-0149-011	5329	Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых и металлических материалов (кремний, медь) для создания нового поколения приборов и устройств для микро- наноэлектроники	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук	40	25	7,5	7,5
12	2014-14-579-0149-012	0705	Разработка кластерной технологии планаризации поверхности диэлектрических материалов (сапфир, кварцевое стекло) для создания нового поколения приборов и	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный	40	25	7,5	7,5

			устройств для различных отраслей промышленности	университет "МИФИ"				
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

Подписи:

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_ Антропов А.П.

Заместитель председателя комиссии

\_\_\_\_\_ Грузинова Е.Н.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Боков М.В.

\_\_\_\_\_ Егоров С.В.

\_\_\_\_\_ Скуратов А.К.

15.09.2014